

ОТЗЫВ

научного руководителя о работе аспиранта МФТИ В.Ю. Шишкова

Я являюсь научным руководителем Шишкова В.Ю. с 2014 г., когда он был студентом пятого курса МФТИ. В 2016 г. он поступил в очную аспирантуру МФТИ. В настоящее время им подготовлена диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Квантовые свойства электромагнитных полей наноразмерных плазмонных систем».

Шишков В.Ю. проявил себя как инициативный и квалифицированный исследователь. За время работы овладел теоретическими и численными методами исследования плазмонных структур с усиливающими компонентами. Он сформировался как исследователь, способный к самостоятельной научной работе. Шишков В.Ю. способен не только решать конкретные научные задачи, но и ставить их.

За время обучения в аспирантуре Шишковым В.Ю. было опубликовано 9 статей в реферируемых журналах из списка ВАК. Научные результаты Шишкова В.Ю. многократно докладывались на международных и российских конференциях. Шишков В.Ю. является стипендиатом фонда «Базис».

Исходя из вышеизложенного, считаю, что Шишков В.Ю. безусловно достоин присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.13 - электрофизика, электрофизические установки.

Характеристика дана для представления в ученый совет Д 999.138.02 при Институте теоретической и прикладной электродинамики РАН при участии Объединенного института высоких температур РАН.

гл. н. с., д. ф.-м. н.

А. А. Пухов

Подпись гл. н. с. А. А. Пухова подтверждаю.
Ученый секретарь Института
теоретической и прикладной
электродинамики РАН, к.ф.-м.н.



А. Т. Кунавин